

H 01 L

Ans.nr.: 0062/83

Int. ans.nr.: PCT/US82/00600

Int. indleveringsdag: 07 maj 1982

Videreførelsesdag: 10 jan 1983

Indleveret: 10 jan 1983

Løbedag: 07 maj 1982

Alm. tilgængelig: 10 jan 1983

Prioritet: 11 maj 1981 US 262380

*NCR CORPORATION; Dayton, US.

Opfinder: James Anthony *Topich; US.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard

Halvlederelement med variabel tærskel

SAMMENDRAG

62-83

Et halvlederelement (100) med variabel tærskel omfatter et halvledersubstrat (11), et lager-siliciumoxidlag (12) med en tykkelse inden for området 25 - 40 Å, et silicium-nitridlag (13), et en grænseflade dannende siliciumoxidlag (14) med en tykkelse inden for området 30 - 60 Å samt en portelektrode (15) af polykrystallinsk silicium. Et sådant halvlederelement har en stor skrivehastighed og et bredt lagerkoblingsvindue. Tykkelsen af nitridlaget (13) kan ligge inden for området 150 - 250 Å, hvilket muliggør anvendelsen af lave skrivespændinger.

FIG. 5B

62-83

